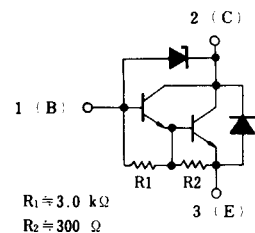


**NPN Silicon Epitaxial
Darlington Transistor**
**Audio Frequency Power Amplifier and
Low Speed Switching
Industrial Use**



2SD1392

電氣的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 40\text{ V}, I_E = 0$			1.0	μA
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE1}	$V_{CE} = 2.0\text{ V}, I_C = 2.0\text{ A}^*$	2000		20000	
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE2}	$V_{CE} = 2.0\text{ V}, I_C = 4.0\text{ A}^*$	500			
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 2.0\text{ A}, I_B = 2.0\text{ mA}^*$			1.5	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = 2.0\text{ A}, I_B = 2.0\text{ mA}^*$			2.0	V
ターンオン時間	t_{on}	$I_C = 2.0\text{ A}, I_{B1} = -I_{B2} = 2.0\text{ mA}$		1.0		μs
蓄 積 時 間	t_{stg}	$R_L = 25\ \Omega, V_{CC} \approx 50\text{ V}$		7.0		μs
下 降 時 間	t_f	測定回路図参照/See Test Circuit		2.0		μs

*パルス測定 $PW \leq 350\ \mu\text{s}$, Duty Cycle $\leq 2\%$

h_{FE} 規格区分 (h_{FE1}) M: 2000~5000 L: 4000~10000 K: 8000~20000

特性曲線/TYPICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

